

KATİHAL FİZİĞİ 2-FİZ 410

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi
Fizik Bölümü

YARIİLETKENLER

3. hafta

Yarıiletken

- **Yarı iletken** üzerine yapılan mekanik işin etkisiyle iletken özelliği kazanabilen, normal şartlar altında yalıtkan olan maddelerdir.
- Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyetik etki veya elektriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını serbest hale geçirerek iletken duruma gelirler. Uygulanan bu dış etki veya etkiler ortadan kaldırıldığında ise yalıtkan duruma geri dönerler. Bu özellik elektronik alanında yoğun olarak kullanılmalarını sağlamıştır.

Neden Yarıiletken?

□ Mutlak sıcaklıkta **yalıtkan**, ısı, ışık, manyetik etki veya elektriksel gerilim gibi dış etkilerle **iletken**



Aynı malzeme hem iletken hem de yalıtkan özellik sergileyebiliyor.

Teknoloji de çığır açtı

Neden Yarıiletken?

- Yarıiletkenler için tam analitik çözümler elde edilebilir (Maxwell-Boltzmann istatistiği)

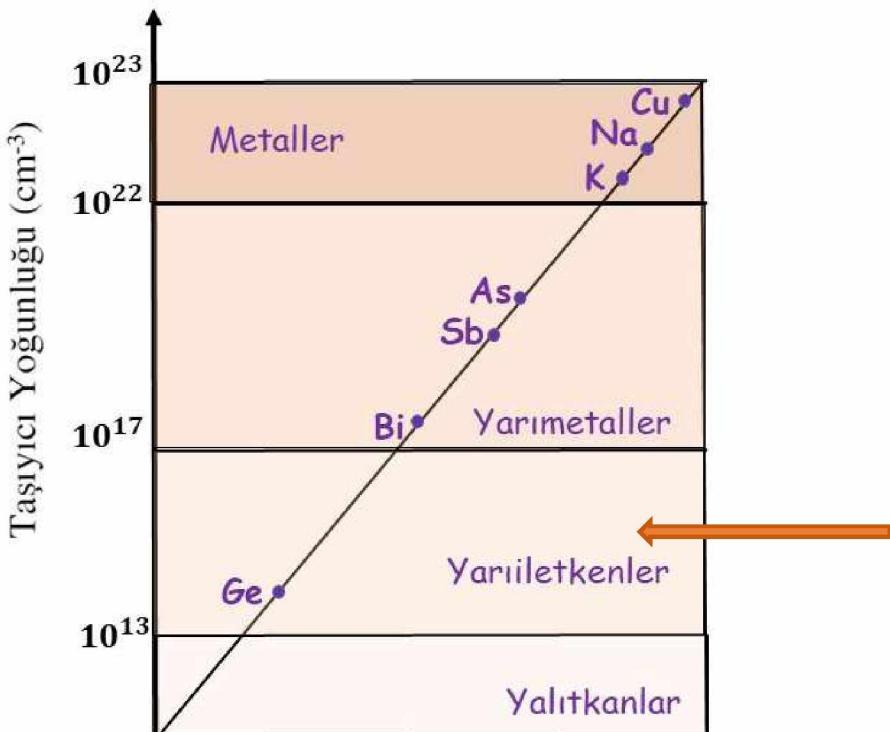
Dağılım fonksiyonları

$$\bullet f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/kT}} \longrightarrow \text{Maxwell-Boltzman dağılım fonksiyonu}$$

$$\bullet f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1} \longrightarrow \text{Fermi-Dirac dağılım fonksiyonu}$$

$$\bullet f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} - 1} \longrightarrow \text{Bose-Einstein dağılım fonksiyonu}$$

İletim elektron yoğunluğu



Yarıiletken bölge safsızlık yoğunluğunu değiştirerek daha yukarıdaki bölgeye doğru büyütülebilir.

Taşıyıcı yükler

- Yük taşıyıcıları

- Metal



sayısı; **sabit** (elektronlar)
hareketlilikleri; **değişken** (sıcaklık, yapı kusurlarının yoğunluğu gibi faktörlerle azaltılıp arttırılabilir)

- Yarıiletken



sayısı; **değişken** (elektronlar ve holler)
hareketlilikleri; **değişken** (sıcaklık vb. faktörler)

Yarıiletkenlerin isimlendirilmesi

- III-V bileşiği: AB → InSb, GaAs

3 değerlikli 5 değerlikli

- II-VI bileşiği: AB → ZnS, CdS

2 değerlikli 6 değerlikli

- IV-IV bileşiği: SiC

PERİYODİK TABLO																	
1A	H	2A															
2	Li	Be															
3	Na	Mg	3B	4B	5B	6B	7B	8B	8B	1B	2B						
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	F
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	Ne
6	Cs	Ba	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu			
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr			
ALKALİ METALLER			TOFRAX ALKALİ METALLER			DİĞER METALLER			GEÇİŞ METALLERİ			ARA GEÇİŞ METALLERİ			YARI METALLER		
SOYGAZLAR			LANTANİT			AKTİNİT											

Bağlanma

- Si: $1s^2 / 2s^2 2p^6 / 3s^2 3p^2$ (14 elektron)

} son yörüngede
4 elektron

- Ge: $1s^2 / 2s^2 2p^6 / 3s^2 3p^6 / 4s^2 3d^{10} 4p^2$ (32 elektron)

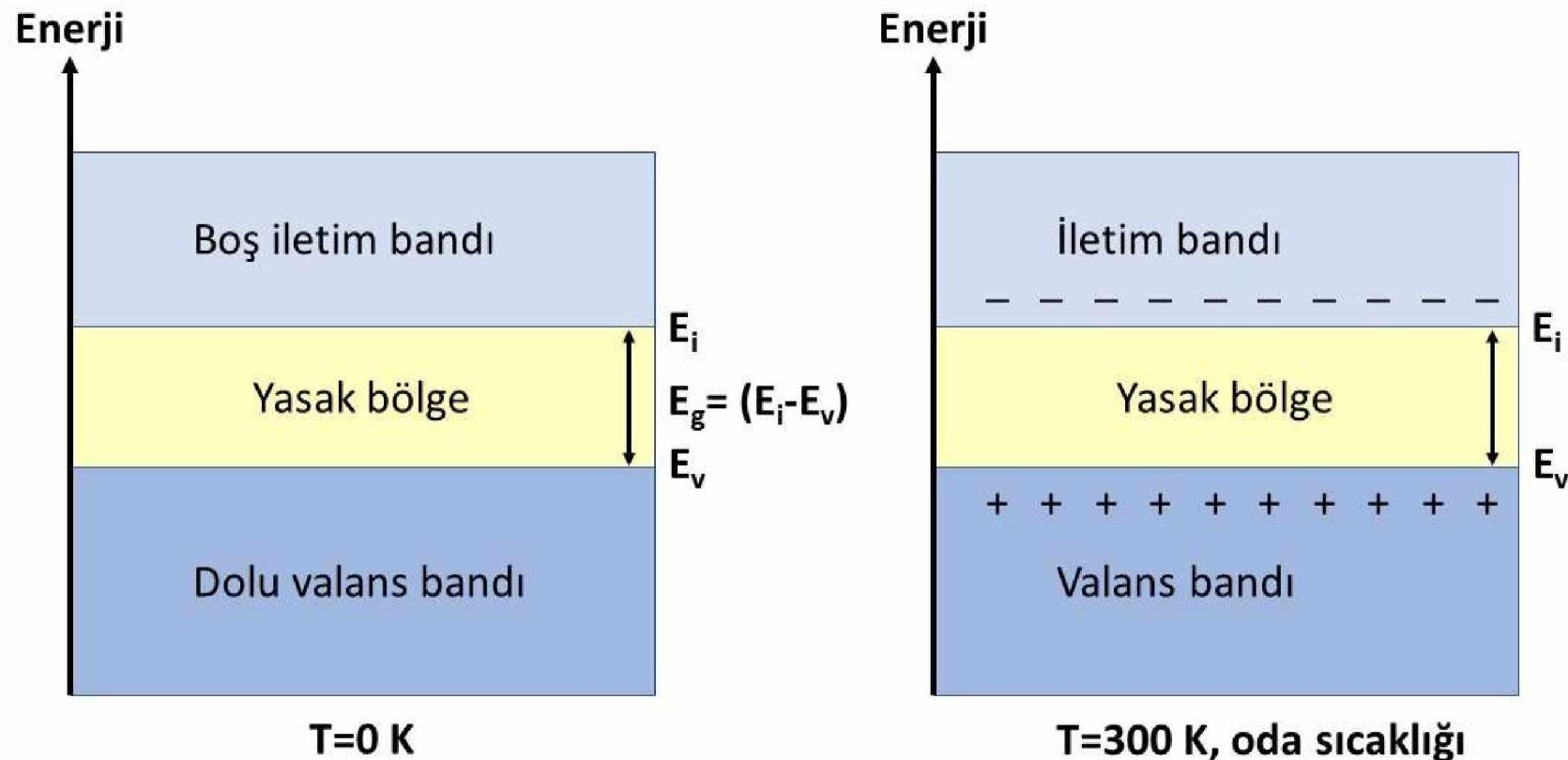
○ Si: $1s^2 / 2s^2 2p^6 / \textcolor{red}{3s}^1 \textcolor{red}{3p}_x^1 \textcolor{red}{3p}_y^1 \textcolor{red}{3p}_z^1$

○ Si: $1s^2 / 2s^2 2p^6 / \textcolor{red}{3s}^1 \textcolor{red}{3p}_x^1 \textcolor{red}{3p}_y^1 \textcolor{red}{3p}_z^1$

} son yörüngede
4 elektron

} sp^3 hibritleşmesi

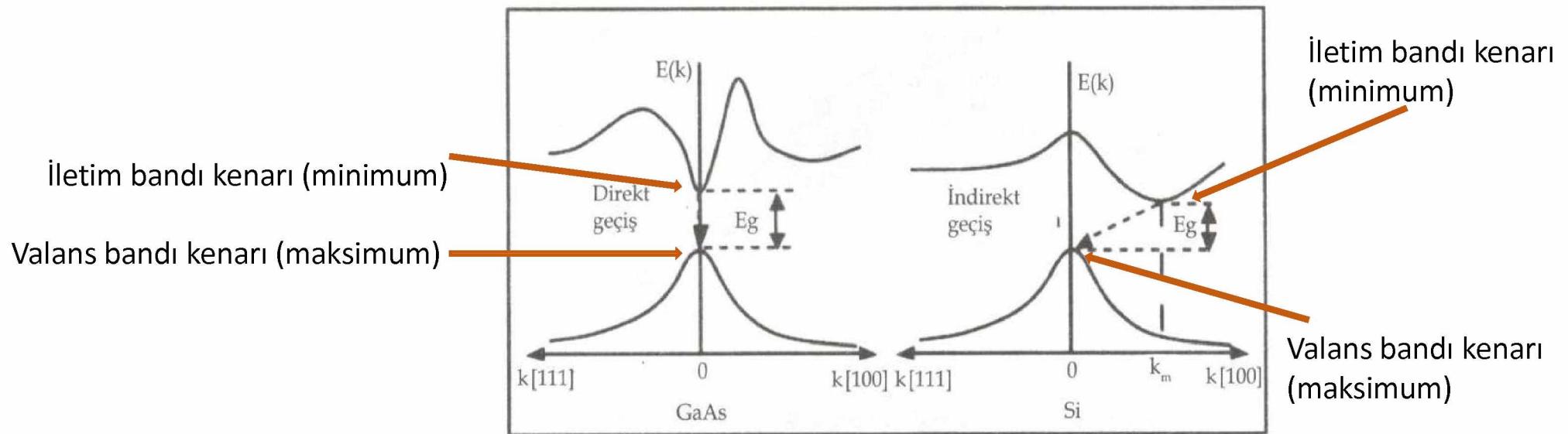
Termal olarak uyarılmış yarıiletken



Yarıiletken bant aralığı

- İçsel (öz) iletkenlik ve içsel (öz) taşıyıcı yoğunluğu büyük oranda $\frac{E_g}{kT}$ ile kontrol edilir.
 - $\frac{E_g}{kT}$ büyükse öz taşıyıcı yoğunluğu ve iletkenlik düşüktür.
- Yarıiletkenler band aralığındaki geçişe göre sınıflandırılabilir;
 - Direkt (doğrudan) band aralığına sahip yarıiletkenler: GaAs, InSb
 - İndirekt(doğrudan olmayan) band aralığına sahip yarıiletkenler: Si, Ge

Yarıiletken bant aralığı



(Şekil Kaynak [2]' den alınmıştır.)

Yarıiletken bant aralığı

- Direkt geçiş: E_g enerjisine sahip kristal tarafından soğurulan bir foton bir elektron ve bir hol (boşluk) yaratır.
- Momentum ve enerji korunur.
- $k=0$ 'daki bir elektron ile $k=0$ 'daki bir hol (k değerleri aynı)
- İşımalı geçiş (LED)

$$h\nu = E_g$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda(\mu m) = 1,24 \frac{eV \cdot \mu m}{E_g (eV)}$$

h , Planck sabiti; ν fotonun frekansı; c ışığın hızı

Yarıiletken bant aralığı

- İndirekt geçiş: İletim bandının minimumu ile valans bandının maksimumu aynı k değerinde değildir.
 - Elektron için $k=(k_m, 0, 0)$
 - Hol için $k=(0, 0, 0)$
- Momentum korunur.
- Hem bir foton hem de bir veya birkaç fononu içerir.

$$k(\text{foton}) = k_c + K$$

$$h\nu = E_g + h\Omega$$

Kaynaklar

1. ‘Katıhal Fiziğine Giriş’, Charles Kittel, (Çeviri: Gülsen Önengüt, Demir Önengüt), 8. baskı, Palme 2014
2. ‘Katıhal Fiziği’, Doç. Dr. Şakir Aydoğan, 1. baskı, Nobel Yayın Dağıtım, 2011
3. ‘Katıhal Fiziği’, Prof. Dr. Mustafa Dikici, 3. baskı, Seçkin Yayıncılık, 1993
4. ‘Katıhal Fiziğine Giriş’, Prof. Dr. Tahsin Nuri Durlu, 2. baskı